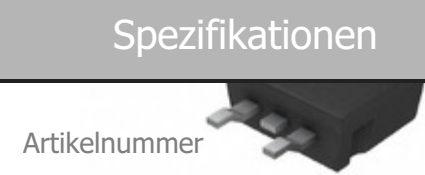


Spezifikationen	
	
Artikelnummer	STB40N60M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 600V 34A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	655 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250μA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK
Serie	MDmesh™ II Plus
Rds On (Max) @ Id, Vgs	88 mOhm @ 17A, 10V
Verlustleistung (max)	250W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2500pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	57nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	34A (Tc)

sein:

STB40100CTR
SMC Diode Solutions
DIODE ARRAY SCHOTTKY 100V
D2PAK



YIC International Co., Limited.

STB40NF03LT4

ST

STB40NF03LT4 ST



STB4045CTR
SMC Diode Solutions
DIODE ARRAY SCHOTTKY 45V
D2PAK



YIC International Co., Limited.

STB40NF03L
ST
STB40NF03L ST



YIC International Co., Limited.

STB40NE03L

ST

STB40NE03L ST



STB4080CTR
SMC Diode Solutions
DIODE ARRAY SCHOTTKY 80V
D2PAK



STB40N20
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 200V 40A D2PAK



Not Actual Photo
YIC International Co., Limited.
STB40NE03L-20T4
 ST
 STB40NE03L-20T4 ST

Mehr

STMicroelectronics	STB40N60M2 Datenblatt	STB40N60M2-Datenblätter	STB40N60M2 PDF	STMicroelectronics STB40N60M2
STB40N60M2 Electronic	STB40N60M2-Komponenten	STB40N60M2-Verteiler	STB40N60M2-Bild	STB40N60M2-Teil
STB40N60M2 Preis	STB40N60M2 Hersteller	STB40N60M2 Bild	STB40N60M2 Aktie	STB40N60M2 Inventar
STB40N60M2 Neu	STB40N60M2 Original	STB40N60M2 garantiert	STB40N60M2 RFQ	STB40N60M2 Online bestellen